



安徽富信半导体科技有限公司

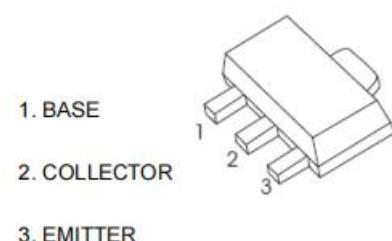
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

2SC3357

SOT-89 Bipolar Transistor 双极型三极管

■ Features 特点

NPN High Frequency 高频



■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V _{CBO}	20	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V _{CEO}	12	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V _{EBO}	3	V
Collector Current 集电极电流	I _C	100	mA
Power dissipation 耗散功率	P _C (T _a =25°C)	350	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	R _{θJA}	357	°C/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T _J , T _{stg}	-55 to +150°C	

■ Device Marking 产品打标

H _{FE}	50-100	80-160	125-250
Mark	RH	RF	RE



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

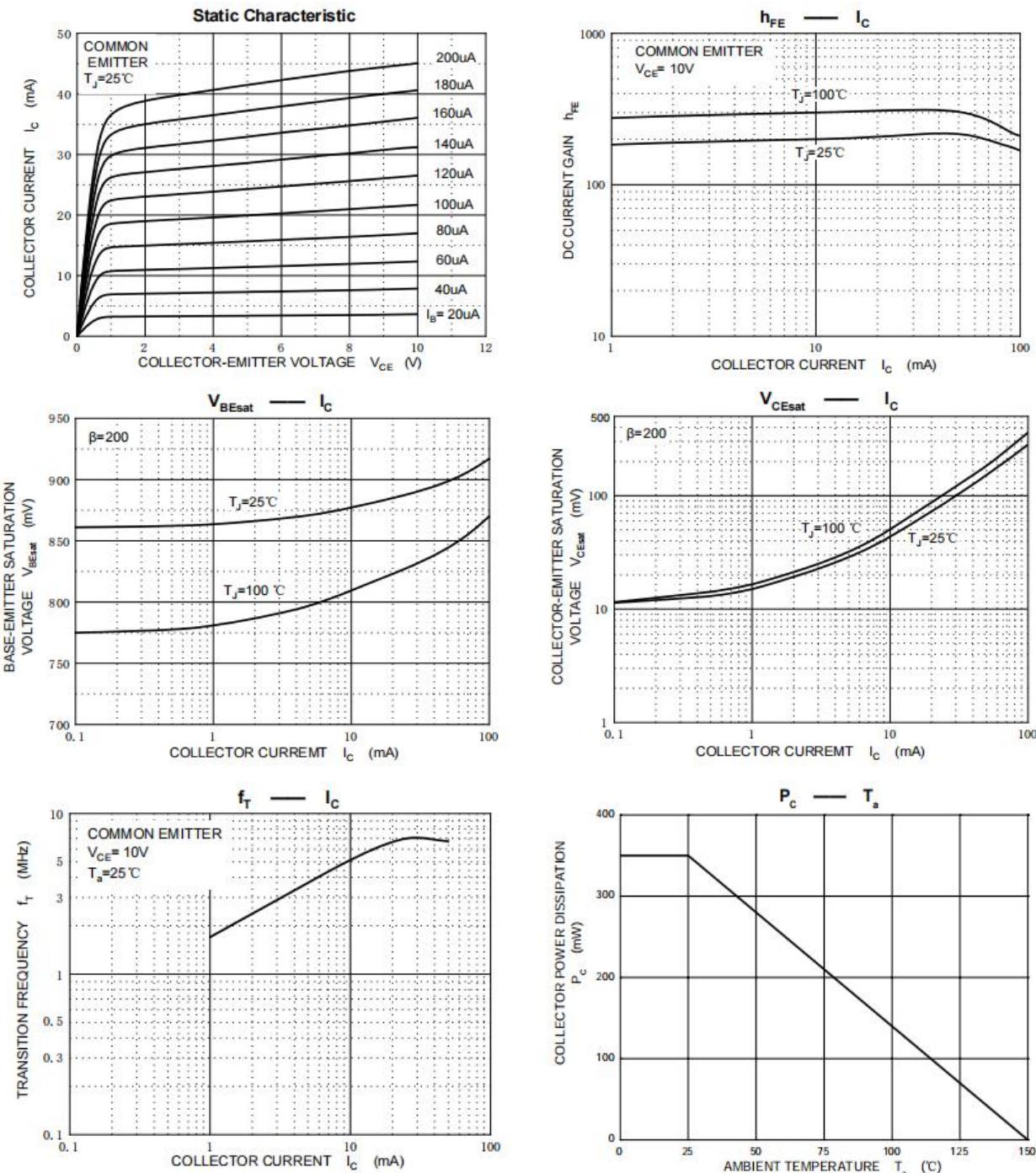
2SC3357

■ Electrical Characteristics 电特性

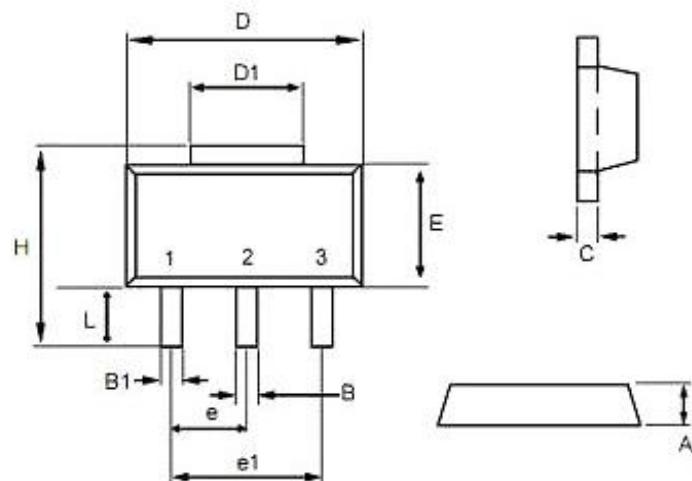
($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压 ($I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	20	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压 ($I_C=100\mu\text{A}$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	12	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压 ($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	3	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流 ($V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	1	μA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流 ($V_{EB}=1\text{V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	1	μA
DC Current Gain 直流电流增益 ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=20\text{mA}$)	H_{FE}	50	—	250	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$)	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	—	—	0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降 ($I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$)	$V_{\text{BE}(\text{sat})}$	—	—	1.15	V
Transition Frequency 特征频率 ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=20\text{mA}$)	f_T	—	6500	—	MHz
Output Capacitance 输出电容 ($V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ob}	—	0.8	1	pF
Noise Figure 噪声系数 ($V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=7\text{mA}$, $f=1\text{GHz}$)	NF	—	1.65	2	dB

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■ Dimension 外形封装尺寸



Dim	min	max
A	1.40	1.60
B	0.40	0.56
B1	0.35	0.48
C	0.35	0.44
D	4.40	4.60
D1	1.35	1.83
e	1.50 BSC	
e1	3.00 BSC	
E	2.29	2.60
H	3.75	4.25
L	0.80	1.20